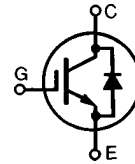


Low $V_{CE(sat)}$ IGBT with Diode
High speed IGBT with Diode

IXGH 17 N100U1
IXGH 17 N100AU1

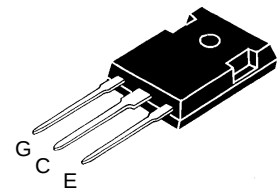
V_{CES}	I_{C25}	$V_{CE(sat)}$
1000 V	34 A	3.5 V
1000 V	34 A	4.0 V

Combi Packs



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1000	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1\text{ M}\Omega$	1000	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	34	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	17	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1 ms	68	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 82\ \Omega$ Clamped inductive load, $L = 100\ \mu\text{H}$	$I_{CM} = 34$ @ $0.8\ V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (M3)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		6	g
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$

TO-247 AD



G = Gate,
E = Emitter,
C = Collector,
TAB = Collector

Features

- International standard package JEDEC TO-247 AD
- IGBT and anti-parallel FRED in one package
- 2nd generation HDMOS™ process
- Low $V_{CE(sat)}$
 - for minimum on-state conduction losses
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity
- Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)
 - soft recovery with low I_{RM}

Applications

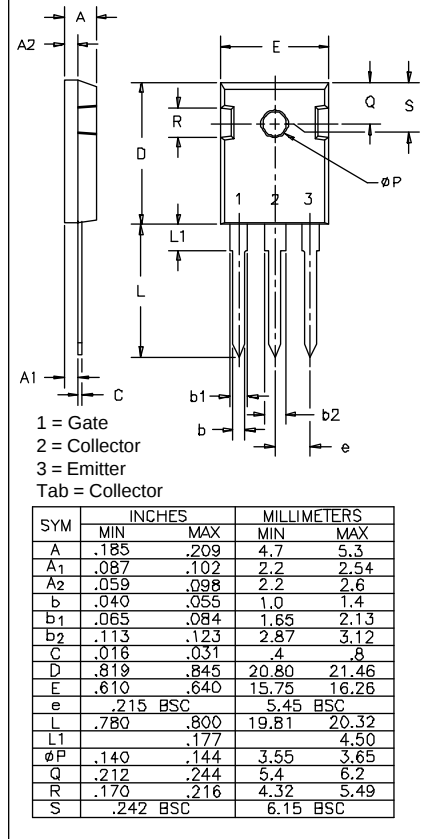
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Advantages

- Saves space (two devices in one package)
- Easy to mount (isolated mounting screw hole)
- Reduces assembly time and cost

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 4.5\text{ mA}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	1000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 500\ \mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ $V_{GE} = 0\text{ V}$			500 μA 8 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 100\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$			3.5 V 4.0 V
				17N100U1 17N100AU1

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	6	15	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		1500	pF
C_{oes}			210	pF
C_{res}			40	pF
Q_g	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		100	nC
Q_{ge}			20	nC
Q_{gc}			60	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$		100	ns
t_{ri}	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $L = 300\text{ }\mu\text{H}$, $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 82\text{ }\Omega$		200	ns
$t_{d(off)}$	Remarks: Switching times may increase		500	1000 ns
t_{fi}	for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G	17N100U1	750	ns
E_{off}		17N100AU1	450	ns
		17N100AU1	3	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$		100	ns
t_{ri}	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $L = 300\text{ }\mu\text{H}$		200	ns
E_{on}	$V_{CE} = 0.8 V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 82\text{ }\Omega$		2.5	mJ
$t_{d(off)}$	Remarks: Switching times may increase		700	1000 ns
t_{fi}	for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G	17N100U1	1200	2000 ns
E_{off}		17N100AU1	750	1000 ns
		17N100U1	8	mJ
		17N100AU1	6	mJ
R_{thJC}				0.83 K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

TO-247 AD Outline


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = I_{C90}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			2.5 V
I_{RM}	$I_F = I_{C90}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $-di_F/dt = 240\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 540\text{ V}$ $I_F = 1\text{ A}$; $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30\text{ V}$		16	18 A
t_{tr}			120	ns
			35	50 ns
R_{thJC}				1 K/W

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025

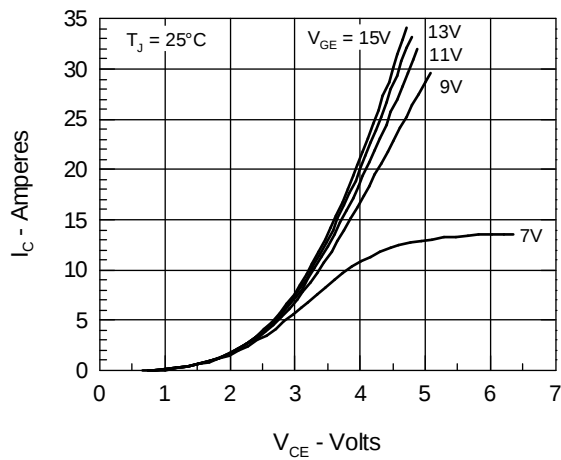
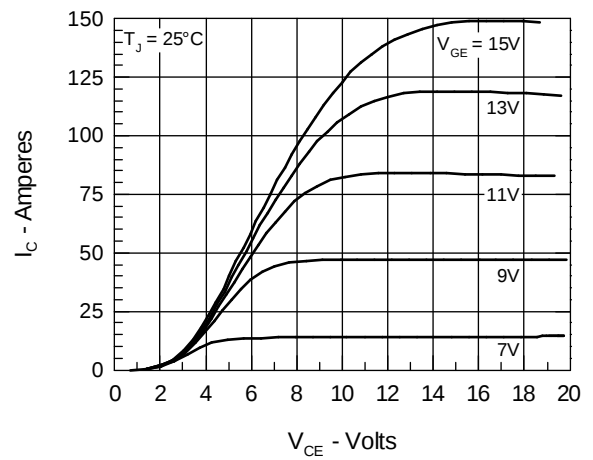
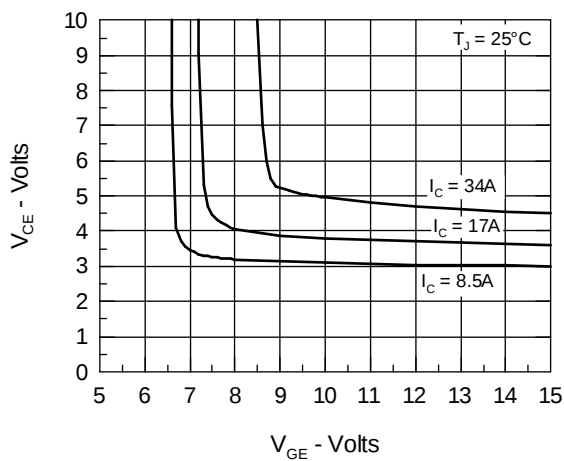
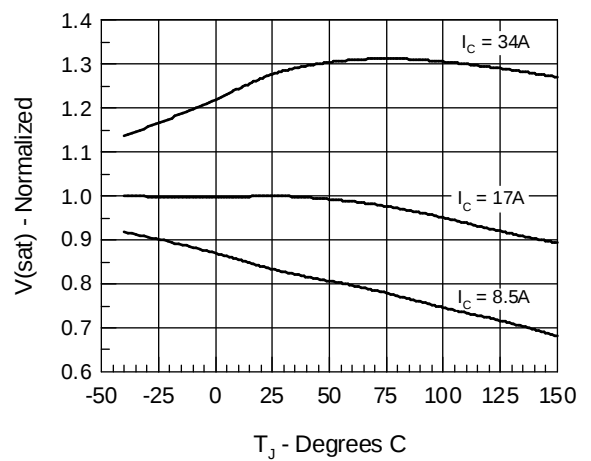
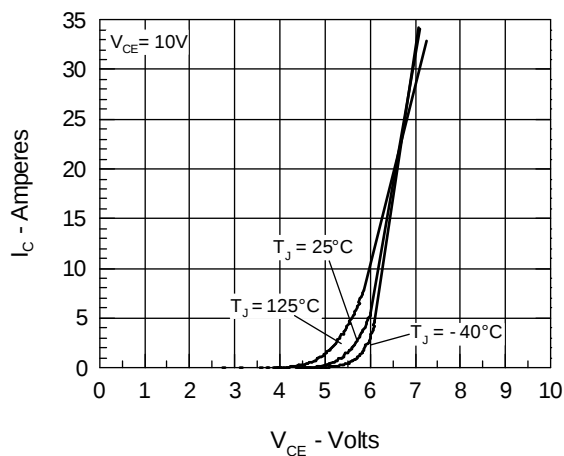
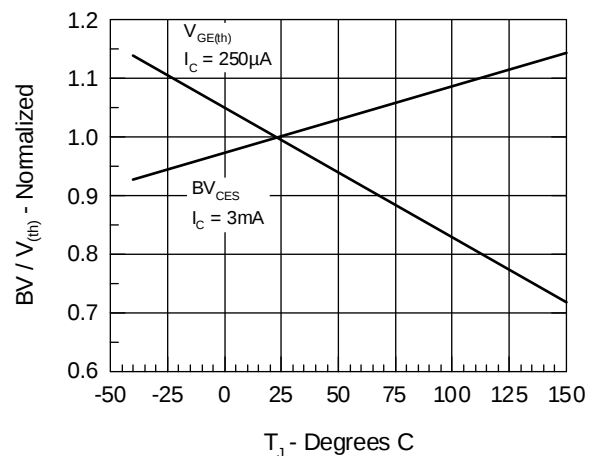
Fig. 1 Saturation Characteristics

Fig. 2 Output Characteristics

Fig. 3 Collector-Emitter Voltage vs. Gate-Emitter Voltage

Fig. 4 Temperature Dependence of Output Saturation Voltage

Fig. 5 Input Admittance

Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage


Fig.7 Gate Charge

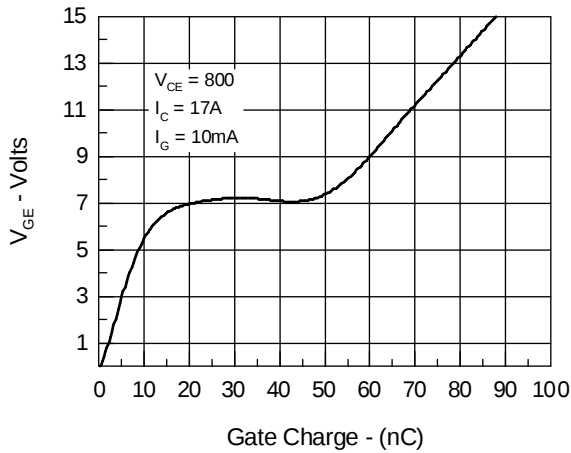


Fig.8 Turn-Off Safe Operating Area

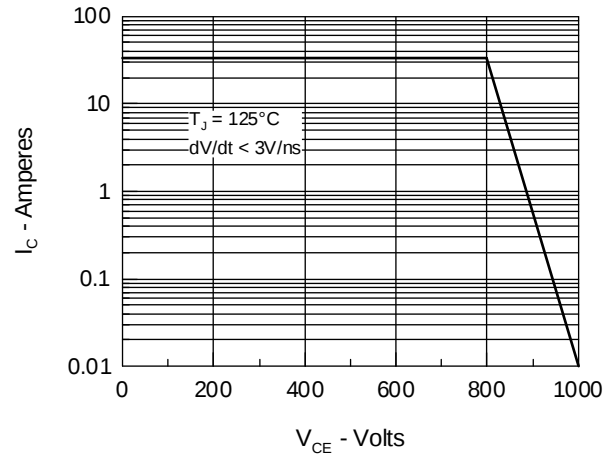


Fig.9 Capacitance Curves

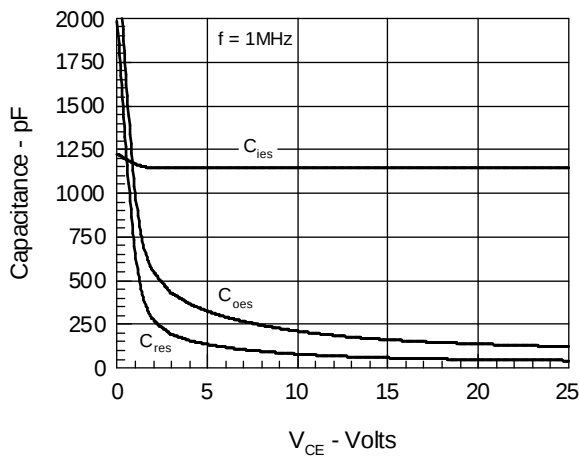
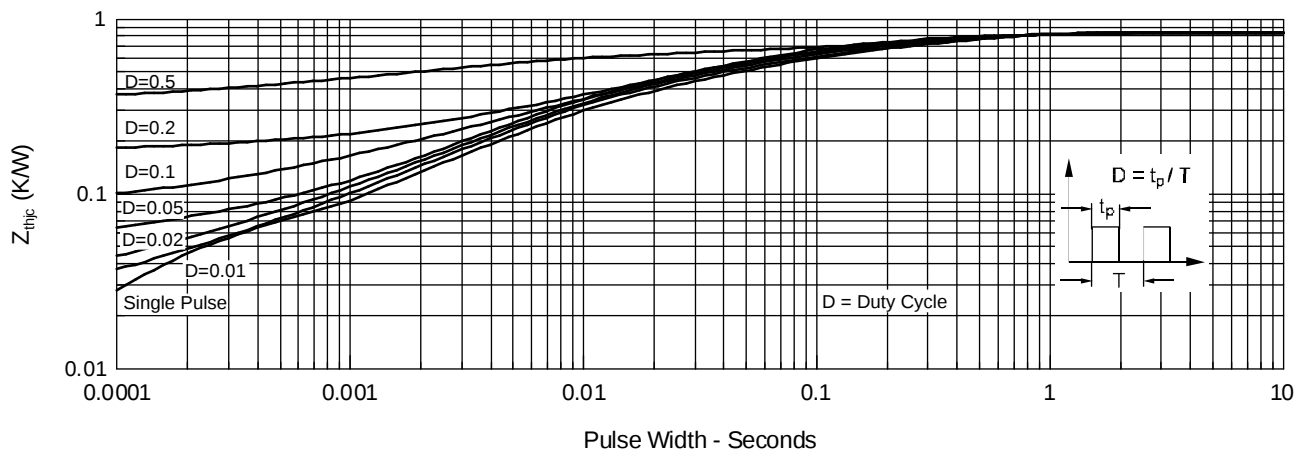


Fig.10 Transient Thermal Impedance



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025

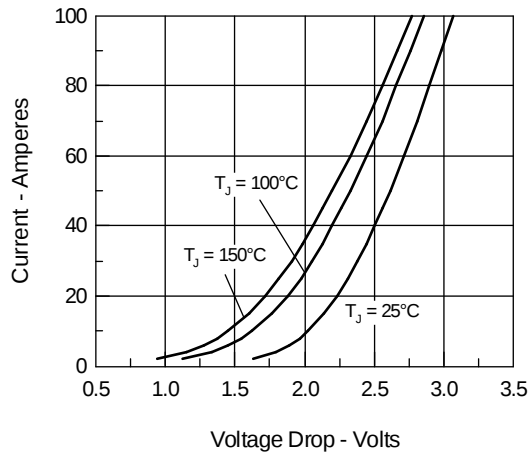
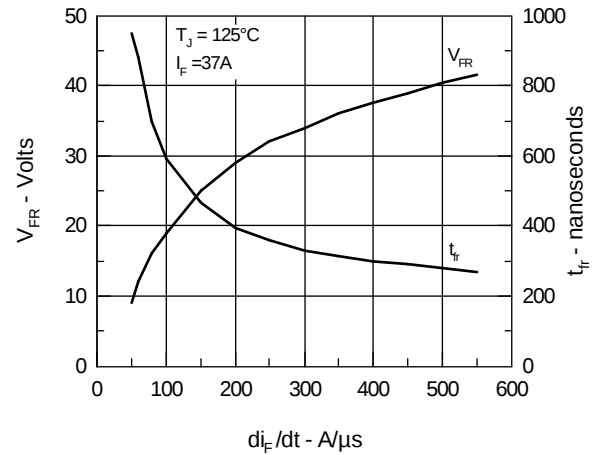
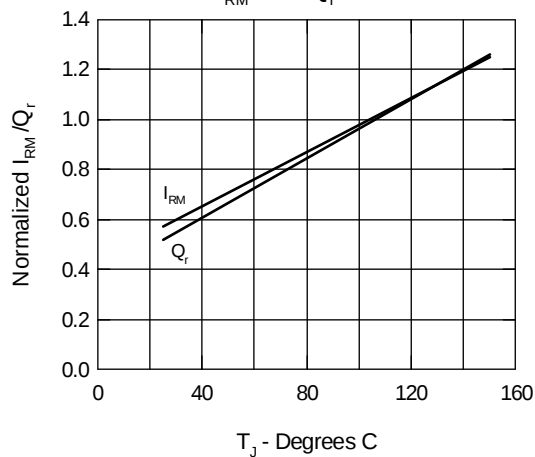
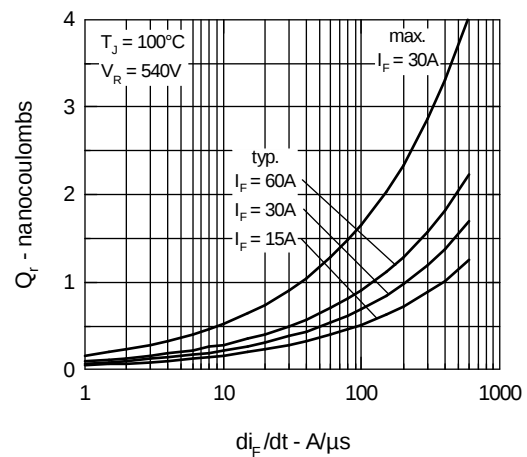
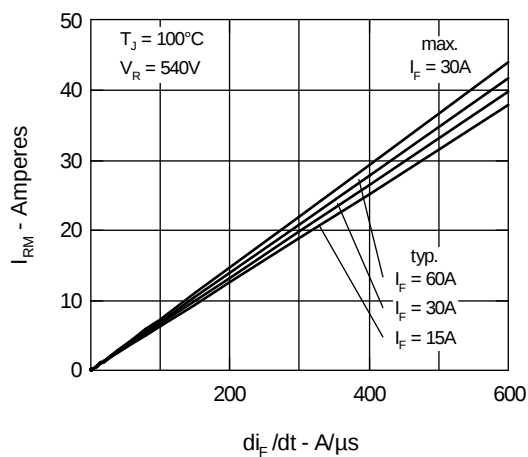
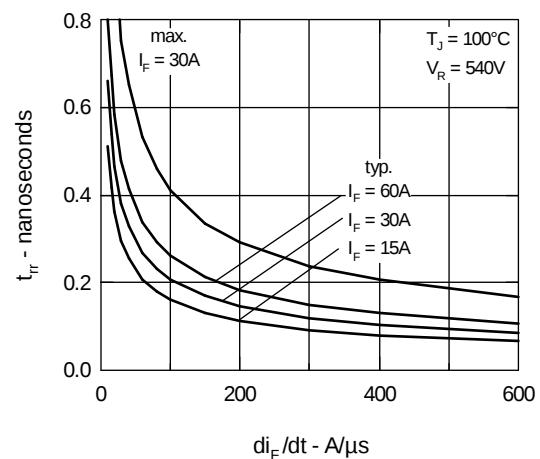
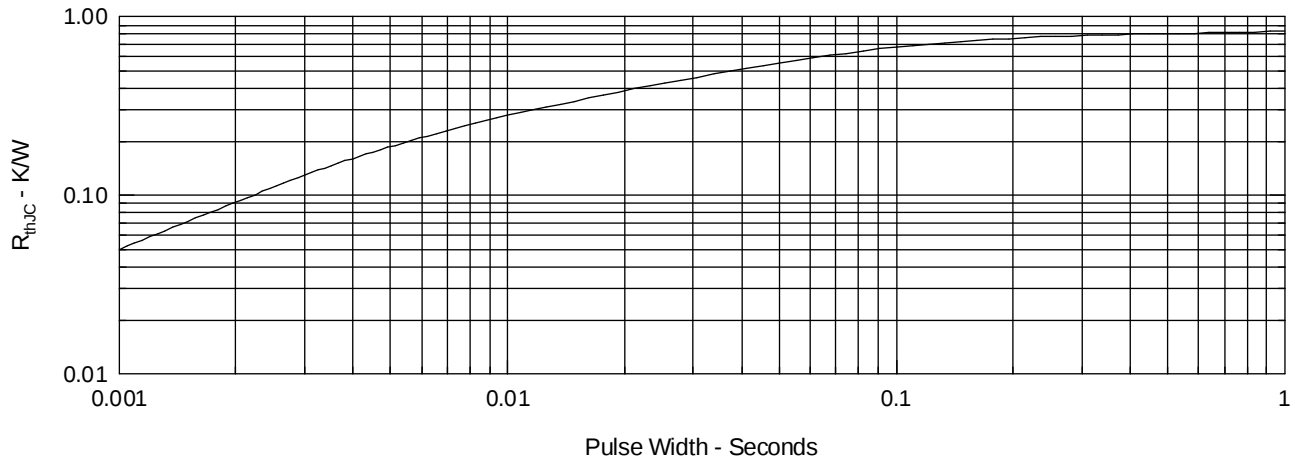
Fig.11 Maximum Forward Voltage Drop

Fig.12 Peak Forward Voltage V_{FR} and Forward Recovery Time t_{fr}

Fig.13 Junction Temperature Dependence of I_{RM} and Q_r

Fig.14 Reverse Recovery Charge Q_r

Fig.15 Peak Reverse Recovery Current

Fig.16 Reverse Recovery Time


Fig.17 Diode Transient Thermal resistance junction to case



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А